

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Том 47, номер 4, 2018

---

---

## Приборы

Особенности протекания фототока в инжекционных структурах на основе плёнок PBSnTe:IN

*Д. В. Ищенко, И. Г. Неизвестный, Н. С. Пашин, В. Н. Шерстякова* 251

Тонкопленочная платформа для химических газовых сенсоров

*И. В. Росляков, К. С. Напольский, В. С. Столяров, Е. Е. Карпов, А. В. Ивашев, В. Н. Суртаев* 256

---

## Технологические процессы микро- и нанoeлектроники

Структурирование меди в плазменной среде ВЧ-разряда

*А. В. Дунаев, Д. Б. Мурин* 265

О влиянии соотношения концентраций фторуглеродных компонентов в смеси CF<sub>4</sub>+C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>+Ag на параметры плазмы и селективность травления SiO<sub>2</sub>/Si

*А. М. Ефремов, Д. Б. Мурин, К.-Н. Kwon* 271

Влияние состава смеси на электрофизические параметры плазмы HCl/N<sub>2</sub>

*С. А. Пивоваренок* 279

---

## Диагностика

Влияние распределения радиационных дефектов на автоэмиссионные свойства кристаллов кремния

*Р. К. Яфаров, В. П. Тимошенко* 283

---

## Моделирование

Моделирование характеристик двух затворных ассиметричнолегированных КНИ КМОП нанотранзисторов

*Н.В. Масальский* 291

---

## Квантовые технологии

Квантовые логические операции на спиновых состояниях в непрерывном СВЧ-поле

*А. Ф. Зиновьева, А. В. Ненашев, А. А. Кошкарев, Т. С. Зароднюк, А. Ю. Горнов, А. В. Двуреченский* 301

---

Вниманию авторов

312

Правила внесения исправлений в pdf\_файлы

314

---

---